

讣告



中国共产党优秀党员、中国工程院院士、中国科学院半导体研究所研究员、我国著名半导体材料学家梁骏吾先生因病医治无效，不幸于2022年6月23日17时在北京逝世，享年89岁。

梁骏吾院士1933年9月18日生于湖北武汉。1955年毕业于武汉大学，1956年至1960年就读于前苏联科学院莫斯科巴依可夫冶金研究所并获得副博士学位，1997年当选中国工程院院士。他先后荣获国家科委科技成果二等奖和新产品二等奖各1次，国家科技进步三等奖1次、中科院重大成果和科技进步一等奖3次、二等奖4次，上海市科技进步二等奖1次等各种科技奖共20余次。

梁骏吾院士从事半导体材料科学研究工作六十多年，是我国早期半导体硅材料的奠基人。上世纪60年代解决了高纯区熔硅的关键技术；1964年制备出室温激光器用GaAs液相外延材料；1979年研制成功为大规模集成电路用的无位错、无旋涡、低微缺陷、低碳、可控氧量的优质硅区熔单晶；80年代首创了掺氮中子嬗变硅单晶，解决了硅片的完整性和均匀性的问题；90年代初研究MOCVD生长超晶格量子阱材料，在晶体完整性、电学性能和超晶格结构控制方面，将中国超晶格量子阱材料推进到实用水平；他还在太阳能电池用多晶硅的研究和产业化等方面发挥着积极作用。

梁骏吾院士一生热爱党、热爱祖国、热爱科学事业！他一生勤奋不辍、学风严谨、务实求真、锐意创新，倾其毕生精力投身于半导体材料科学事业！他待人忠厚宽容，光明磊落，做事身体力行，处世淡

泊名利！他的逝世，是我国科学界和教育界的重大损失！他的精神，将激励后人奋进前行！他的业绩和品德，将为中国科技事业树立一座不朽的丰碑。对梁骏吾院士的逝世，我们表示深切的哀悼！

梁骏吾院士永垂不朽！梁骏吾院士精神永存！

梁骏吾院士治丧委员会决定以下事项：

2022年6月27日—6月30日每天9:00—16:00在中国科学院半导体研究所学术会议中心设立灵堂供各界人士吊唁。

谨此讣告。

梁骏吾院士治丧委员会

2022年6月23日